Документ получення получення российской федерации и выс информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректо **Редеральное** государственное автономное образовательное учреждение Дата подписания: 12.10.2023 12:49:17 высшего образования

Уникальный профрациональный исследовательский технологический университет «МИСИС»

d7a26b9e8ca85e98ec3de2eb454b4659d061f249

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Мессбауэровская спектроскопия материалов магнитоэлектроники и микросистемной техники

Закреплена за подразделением Кафедра технологии материалов электроники

Направление подготовки 11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА

Профиль

Квалификация Инженер-исследователь

 Форма обучения
 очная

 Общая трудоемкость
 5 ЗЕТ

Часов по учебному плану 180 Формы контроля в семестрах:

в том числе: экзамен 10

 аудиторные занятия
 68

 самостоятельная работа
 76

 часов на контроль
 36

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	10 (5.2)		Итого		
Недель	1	8			
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ	
Лекции	34	34	34	34	
Лабораторные	17	17	17	17	
Практические	17	17	17	17	
Итого ауд.	68	68	68	68	
Контактная работа	68	68	68	68	
Сам. работа	76	76	76	76	
Часы на контроль	36 36		36	36	
Итого	180	180	180	180	

Программу составил(и):

Рабочая программа

Мессбауэровская спектроскопия материалов магнитоэлектроники и микросистемной техники

Разработана в соответствии с ОС ВО:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» по направлению подготовки 11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (приказ от 28.06.2023 г. № 292 о.в.)

Составлена на основании учебного плана:

11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА, 11.03.04-БЭН-23_6-ПП.plx , утвержденного Ученым советом НИТУ МИСИС в составе соответствующей ОПОП ВО 22.06.2023, протокол № 5-23

Утверждена в составе ОПОП ВО:

11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА, , утвержденной Ученым советом НИТУ МИСИС 22.06.2023, протокол № 5-23

Рабочая программа одобрена на заседании

Кафедра технологии материалов электроники

Протокол от 18.06.2020 г., №10

Руководитель подразделения Костишин Владимир Григорьевич

стр. 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Целью освоения дисциплины Мёссбауэровская спектроскопия материалов нано- и микросистемной техники является подготовка выпускников к научно-исследовательской деятельности при выполнении междисциплинарных проектов в профессиональной области, в том числе в интернациональном коллективе, в части использования мёссбауэровской спектроскопии в вопросах исследования состава, структуры и свойств материалов нано- и микросистемной техники.

В.Б.В.ДЕ.15 Пребования к предварительной поли этовке обучающегоск:		2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ					
2.1.1 Методы математического моделирования 2.1.2 Методы характеризации полутроводниковых материалов и структур 2.1.3 Моделирование процессов и устройств полутроводниковый электроники 2.1.4 Силовые полутроводниковые приборы 2.1.5 Современные методы диагностики и исследования наногетероструктур 2.1.6 Физика квантоворазмерных полутроводниковых композиций 2.1.7 Физико-кимия и технология наноструктур 2.1.8 Физико-кимия и технология наноструктур 2.1.9 Вакумная и плазменная электроника 2.1.10 Квантоворазмерных структуры в нанослектронике 2.1.11 Магинтине имерения 2.1.12 Магематические модели технологических процессов получения материалов электронной техники 2.1.13 Моделирование технологических процессов получения материалов электронной техники 2.1.14 Напослектронных полутроводинковых приборов и устройств 2.1.15 Оборудование производства феритовых материалов и раднокерамики 2.1.16 Основы раднационной стойкости изделий электронной техники 2.1.17 Основы раднационной стойкости изделий электронной техники 2.1.18 Приборы квантогов й устройкости в раднокераники 2.1.		Блок ОП: Б1.В.ДВ.15					
2.1.2 Методы характеризации полупроводниковых материалов и структур 2.1.3 Моделирование процессов и устройств полупроводниковой электроники 2.1.4 Силовые полупроводниковые приборы 2.1.5 Современные методы диагиостики и исследования наностероструктур 2.1.6 Физика кванговоразмерных полупроводниковых композиций 2.1.7 Физико-кимия и технология наноструктур 2.1.8 Физико-кимия и технология наноструктур 2.1.9 Вакуумия и палусения электронике 2.1.10 Каштоворазмерные структуры в изиоэлектронике 2.1.11 Математические модели технологических процессов получения магриалов электроники и радиокерамики 2.1.12 Маселирование технологических процессов получения магриалов зактроний техники 2.1.13 Оборудование производства ферритовых материалов и устройств 2.1.14 Наиоэлектроника полупроводимовых приборов в устройств 2.1.15 Оборудование производства ферритовых материалов и раднокерамики 2.1.16 Основы технология лактронной компонентной базы 2.1.17 Основы технология электронной компонентной базы 2.1.18 Приборы квантовой и отитческой электронной обмогонителной базы 2.1.19 Пропессы вакуумной и паламенной электрон	2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:					
 2.1.3 Моделирование процессов и устройств полупроводниковых ризборы 2.1.4 Силовые полупроводниковые приборы 2.1.5 Современные методы диагностики и исследования наногетероструктур 2.1.6 Физика квантоворазмерных полупроводниковых композиций 2.1.7 Физика наноструктур 2.1.8 Физико-химия и технология наноструктур 2.1.9 Вакуумная и платменная электроника 2.1.10 Квантоворазмерные структуры в наноэлектронике 2.1.11 Магингные измерсния 2.1.12 Магематические модели технологических процессов получения магнитоэлектроники и радиокерамики 2.1.13 Моделирование технологических процессов получения магнитоэлектронной техники 2.1.14 Наноэлектроника полупроводниковых приборов в устройств 2.1.15 Оборудование производства ферритовых материалов и радиокерамики 2.1.16 Основы радиационной стойкости изделий электронной 2.1.17 Основы технологии электронной компонентной базы 2.1.18 Приборы квантовой и оптической электронники 2.1.20 Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики 2.1.21 Физика взаимодейства частии и излучений с веществом 2.1.22 Элементы и устройства магинтоэлектроники 2.1.23 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах 2.1.24 Ионно-плазменная обработка материалов 2.1.25 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники 2.1.26 Материаловедение ферритов и родственных магинтых систем 2.1.27 Метода исследования материалов и структур электроники 2.1.28 Основы проектирования электронной компонентной базы. Технология тонких пленох 2.1.29 Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленох 2.1.21 Полупроводниковая наноэлектронной компонентной базы. Технология тонких пленох 2.1.23 Приемники оптического излучения 2.1.34 Физика минульсного отжита 2.1.35 Физические основы электронной	2.1.1	Методы математического моделирования					
2.1.4 Силовые полупроводниковые приборы 2.1.5 Современные методы днагностики и исследования наностероструктур 2.1.6 Офизика выптоворазмерных полупроводниковых композиций 2.1.7 Физика наноструктур 2.1.8 Физико-кимия и технология наноструктур 2.1.9 Вакуумная и плазменная электроника 2.1.10 Квантоворазмерные структуры в наноэлектронике 2.1.11 Магинтные измерения 2.1.12 Магематические модели технологических процессов получения материалов электроники и раднокерамики 2.1.13 Моделирование технологических процессов получения материалов электроники и раднокерамики 2.1.14 Напоэлектроника полупроводниковых ириборов и устройств 2.1.15 Оборудование производства ферритовых материалов и раднокерамики 2.1.16 Основы раднационной стойкости изделий электронной техники 2.1.17 Основы технологии электронной компонентной базы 2.1.18 Приборы квантовой и питической электронной 2.1.19 Происсеы вакуумной и плазменной электронной 2.1.21 Физика взанмодействия части и и злучений с веществом 2.1.22 Элементы и устройства материалов котруктур 2.1.23 Дефекты в оптоэлек	2.1.2	Методы характеризации полупроводниковых материалов и структур					
 2.1.5 Современные методы диагностики и исследования наногетероструктур 2.1.6 Физика кванговоразмерных полупроводниковых композиций 2.1.7 Физика наноструктур 2.1.8 Физико-химия и технология наноструктур 2.1.9 Вакуумивя и платменнав электроника 2.1.10 Квантоворазмерные структуры в наноэлектронике 2.1.11 Матинтые измерения 2.1.12 Математические модели технологических процессов получения магинтоэлектроники и раднокерамики 2.1.13 Моленирование технологических процессов получения магинтоэлектроники и раднокерамики 2.1.14 Наноэлектроника полупроводниковых приборов и устройств 2.1.15 Оборудование производства ферритовых материалов электронной техники 2.1.16 Основы радиационной стойкости изделий электронной техники 2.1.17 Основы радиационной стойкости изделий электронной техники 2.1.18 Приборы квантовой и оптической электронники 2.1.19 Процессы вакуумной и шаязменной электроники 2.1.20 Технология производства ферритовых материалов и раднокерамики 2.1.21 Физика взаимодействия частиц и изирчений с веществом 2.1.22 Дементы и устройства мантитоэлсктроники 2.1.23 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на пирокозонных материалах 2.1.24 Иоино-плазменная обработка материалов 2.1.25 Компьотерные технологии проектирования процессов наноэлектроники 2.1.26 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем 2.1.27 Методы исследования материалов и структур электроники 2.1.28 Основы проектирования электронной компонентной базы. Технология тонких пленок 2.1.29 Полупроводниковые приборы 2.1.31 Полупроводниковая наноэлектронной 2.1.32 Приемники оптического сизучения 2.1.33 Физические основы электронной 2.1.34 Физики милупьеного отжити 2.1.35 Физические основы электронной 2.1.36 Функциональная нанологектроника 2.1.37 Биполарные полупр	2.1.3	Моделирование процессов и устройств полупроводниковой электроники					
2.1.6 Физика квантоворазмерных полупроводниковых композиций 2.1.7 Физика напоструктур 2.1.8 Физико-химия и технология напоструктур 2.1.9 Вакуумная и плазменная электроника 2.1.10 Квантоворазмерные структуры в наноэлектронике 2.1.11 Магнитные измерения 2.1.12 Математические модели технологических процессов получения магнитоэлектроники и раднокерамики 2.1.13 Моделирование технологических процессов получения магнитоэлектроники и раднокерамики 2.1.14 Наноэлектроника полупроводниковых приборов и устройств 2.1.15 Оборудование производства ферритовых материалов и раднокерамики 2.1.16 Основы раднационной стойкости изделий электронной техники 2.1.17 Основы раднационной стойкости изделий электронной техники 2.1.18 Приборы квантовой и оптической электроники 2.1.19 Процессы вакуумной и плазменной электронники 2.1.20 Технология производства ферритовых материалов и раднокерамики 3.1.21 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах 2.1.22 Элементы и устройства магнитоэлектроники 2.1.23 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах 2.1.24 Иопно-плазменная обработка материалов 2.1.25 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники 2.1.26 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем 3.1.27 Методы исследования материалов 2.1.28 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ 3.1.30 Полевые полупроводниковые приборы 3.1.31 Полупроводниковая наноэлектронной компонентной базы. Технология тонких пленок 3.1.33 Онзика интульсного отжита 3.1.34 Физика интульсного отжита 4.1.35 Физические основы электронной 4.1.36 Функциональная наноэлектронной 4.1.38 Инженерная математика	2.1.4	Силовые полупроводниковые приборы					
2.1.7 Физика наноструктур 2.1.8 Физико-кымия и технология наноструктур 2.1.9 Вакуумная и плазменная электроника 2.1.10 Квантоворазмерные структуры в наноэлектронике 2.1.11 Магематические модели технологических процессов получения матичтоэлектроники и радиокерамики 2.1.12 Магематические модели технологических процессов получения материалов электронной техники 2.1.13 Моделирование технологических процессов получения материалов электронной техники 2.1.14 Накоэлектроника полупроводниковых приборов и устройств 2.1.15 Оборудование производства ферритовых материалов в радиокерамики 2.1.16 Основы радиационной стойкости изделий электронной техники 2.1.17 Основы технологии электронной компонентной базы 2.1.19 Процессы вакуумной и плазменной электроники 2.1.20 Технология производства ферритовых материалов и раднокерамики 2.1.21 Отизна взаимодействия частиц и излучений с веществом 2.1.22 Элементы и устройства магнитоэлектроники 2.1.23 Дефекты в отгоэлектронных полупроводниковых приборы 2.1.24 Ионно-плазменная обработка материалов 2.1.25 Компьютерные технология проектроныем	2.1.5	Современные методы диагностики и исследования наногетероструктур					
2.1.8 Физико-химия и технология наноструктур 2.1.9 Вакуумиая и плазменная электроника 2.1.10 Квантоворазмерные структуры в наноэлектронике 2.1.11 Матеитные измерения 2.1.12 Матеитные измерения 2.1.13 Моделирование технологических процессов получения материалов электронной техники 2.1.14 Наноэлектроника полупроводниковых приборов и устройств 2.1.15 Оборудование производства ферритовых материалов и радиокерамики 2.1.16 Основы радиационной стойкости изделий электронной техники 2.1.17 Основы радиационной стойкости изделий электронной техники 2.1.18 Приборы квантовой и оптической электроники 2.1.19 Процессы вакумной и плазменной электроники 2.1.20 Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики 2.1.21 Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом 2.1.22 Элементы и устройства матиигоэлектроники 2.1.23 Дефекты в онтоэлектроных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах 2.1.24 Ионно-плазменная обработка материалов 2.1.25 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники 2.1.26 Материаловедение фер	2.1.6	Физика квантоворазмерных полупроводниковых композиций					
2.1.9 Вакуумная и плазменная электроника 2.1.10 Квантоворазмерные структуры в наноэлектронике 2.1.11 Магнитные измерения 2.1.12 Магематические модели технологических процессов получения магнитоэлектроники и раднокерамики 2.1.13 Моделирование технологических процессов получения материалов электронной техники 2.1.14 Наноэлектроника полупроводниковых приборов и устройств 2.1.15 Оборудование производства ферритовых материалов в раднокерамики 2.1.16 Оеновы радиационной стойкости изделий электронной техники 2.1.17 Основы технологии электронной компонентной базы 2.1.18 Приборы квантовой и оптической электроники 2.1.19 Процессы вакуумной и плазменной электроники 2.1.20 Технология производства ферритовых материалов и раднокерамики 2.1.21 Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом 2.1.22 Элементы и устройства магнитоэлектроники 2.1.23 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах 2.1.24 Ионно-плазменная обработка материалов и структур электроники 2.1.25 Компьютерные технологии проектирования прицессов наноэлектроники 2.1.26 Материаловедение ферритов и ро	2.1.7	Физика наноструктур					
2.1.10 Квантоворазмерные структуры в наноэлектронике 2.1.11 Магнитные измерения 2.1.12 Магематические модели технологических процессов получения магитоэлектроники и радиокерамики 2.1.13 Моделирование технологических процессов получения материалов электронной техники 2.1.14 Наноэлектроника полупроводниковых приборов и устройств 2.1.15 Оборудование производства ферритовых материалов и радиокерамики 2.1.16 Основы радиационной стойкости изделий электронной техники 2.1.17 Основы технологии электронной компонентной базы 2.1.18 Проборы квантовой и оптической электроннки 2.1.21 Процессы вакуумной и плазменной электроники 2.1.22 Технология производства ферритовых материалов и раднокерамики 2.1.21 Физика взаимодействия частиц и излучений е веществом 2.1.22 Элементы и устройства магнитоэлектроники 2.1.23 Дефекты в отгоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалох 2.1.24 Ионно-плазменная обработка материалов 2.1.25 Компьютерные технологии проектирования материалов 2.1.26 Компьютерные технологии проектирования материалов 2.1.27 Методы иследования материалов и структур электроники<	2.1.8	Физико-химия и технология наноструктур					
2.1.11 Магнитные измерения 2.1.12 Магематические модели технологических процессов получения магнитоэлектроники и радиокерамики 2.1.13 Моделирование технологических процессов получения материалов электронной техники 2.1.14 Наноэлектроника полупроводниковых приборов и устройств 3.1.15 Оборудование производства ферритовых материалов и радиокерамики 2.1.16 Основы радиационной стойкости изделий электронной техники 2.1.17 Основы технологии электронной компонентной базы 2.1.18 Приборы квантовой и оптической электронной и 2.1.19 Процессы вакуумной и плазменной электроники 2.1.20 Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики 2.1.21 Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом 3.1.22 Элементы и устройства магнитоэлектроники 2.1.23 Дефекты в оптоэлектроннах полупроводниковых приборах на широкозонных материалах 2.1.24 Ионно-плазменная обработка материалов 2.1.25 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники 2.1.26 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем 2.1.27 Методы исследования материалов и структур электроники 2.1.28 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ 2.1.29 Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок 2.1.31 Полевые полупроводниковые приборы 2.1.32 Приемники оптического излучения 2.1.33 Физико-математические модели процессов наноэлектроники 2.1.34 Физико-математические модели процессов наноэлектроники 2.1.35 Физико-математические модели процессов наноэлектроники 2.1.36 Функциональная наноэлектроники 2.1.37 Биполярные полупроводниковые приборы 2.1.38 Инженерная математика	2.1.9	Вакуумная и плазменная электроника					
2.1.12 Математические модели технологических процессов получения магнитоэлектроники и радиокерамики 2.1.13 Моделирование технологических процессов получения материалов электронной техники 2.1.14 Наноэлектроника полупроводниковых приборов и устройств 2.1.15 Оборудование производства ферритовых материалов и радиокерамики 2.1.16 Основы технологии электронной компонентной базы 2.1.17 Основы технологии электронной компонентной базы 2.1.18 Приберы квантовой и оптической электроники 2.1.19 Процессы вакуумной и плаэменной электроники 2.1.20 Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики 2.1.21 Фтанка взаимодействия частиц и излучений с веществом 2.1.22 Элементы и устройства магнитоэлектроники 2.1.23 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах 2.1.24 Ионно-плазменная обработка материалов 2.1.25 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники 2.1.26 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем 2.1.27 Методы исследования материалов и структур электроники 2.1.28 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ	2.1.10	Квантоворазмерные структуры в наноэлектронике					
2.1.13 Моделирование технологических процессов получения материалов электронной техники 2.1.14 Наноэлектроника полупроводниковых приборов и устройств 2.1.15 Оборудование производства ферритовых материалов и радиокерамики 2.1.16 Основы радиационной стойкости изделий электронной техники 2.1.17 Основы технологии электронной компонентной базы 2.1.18 Приборы квантовой и оптической электроники 2.1.20 Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики 2.1.21 Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом 2.1.22 Элементы и устройства магнитоэлектроники 2.1.23 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах 2.1.24 Ионно-плазменная обработка материалов 2.1.25 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники 2.1.26 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем 2.1.27 Методы исследования материалов и структур электронники 2.1.28 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ 2.1.29 Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок 2.1.30 Полупроводниковая наноэлектронной обминентной базы. Технология тонких пленок	2.1.11	Магнитные измерения					
2.1.13 Моделирование технологических процессов получения материалов электронной техники 2.1.14 Наноэлектроника полупроводниковых приборов и устройств 2.1.15 Оборудование производства ферритовых материалов и радиокерамики 2.1.16 Основы радиационной стойкости изделий электронной техники 2.1.17 Основы технологии электронной компонентной базы 2.1.18 Приборы квантовой и оптической электроники 2.1.20 Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики 2.1.21 Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом 2.1.22 Элементы и устройства магнитоэлектроники 2.1.23 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах 2.1.24 Ионно-шазменная обработка материалов 2.1.25 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники 2.1.26 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем 2.1.27 Методы исследования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ 2.1.28 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ 2.1.30 Полевые полупроводниковые приборы 2.1.31 Полупроводниковая наноэлектроники 2.1.32 Физико-м	2.1.12	Математические модели технологических процессов получения магнитоэлектроники и радиокерамики					
2.1.15 Оборудование производства ферритовых материалов и радиокерамики 2.1.16 Основы радиационной стойкости изделий электронной техники 2.1.17 Основы технологии электронной компонентной базы 2.1.18 Приборы квантовой и оптической электроники 2.1.19 Процессы вакуумной и плазменной электроники 2.1.20 Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики 2.1.21 Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом 2.1.22 Элементы и устройства магнитоэлектроники 2.1.23 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах 2.1.24 Ионно-плазменная обработка материалов 2.1.25 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники 2.1.26 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем 2.1.27 Методы исследования материалов и структур электронных 2.1.29 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ 2.1.29 Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок 2.1.30 Полевые полупроводниковые приборы 2.1.31 Полупроводниковая наноэлектроника 2.1.32 Оризика импульсного отжига 2.1.33 Физико-математические модели	2.1.13						
2.1.16 Основы радиационной стойкости изделий электронной техники 2.1.17 Основы технологии электронной компонентной базы 2.1.18 Приборы квантовой и оптической электроники 2.1.19 Процессы вакуумной и плазменной электроники 2.1.20 Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики 2.1.21 Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом 2.1.22 Элементы и устройства магнитоэлектроники 2.1.23 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах 2.1.24 Ионно-плазменная обработка материалов 2.1.25 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники 2.1.26 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем 2.1.27 Методы исследования материалов и структур электроники 2.1.28 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ 2.1.29 Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок 2.1.30 Полупроводниковые приборы 2.1.31 Полупроводниковые приборы 2.1.33 Физика импульсного отжига 2.1.34 Физика импульсного отжига 2.1.35 Физические основы электроники 2.1.36 <	2.1.14	Наноэлектроника полупроводниковых приборов и устройств					
2.1.17 Основы технологии электронной компонентной базы 2.1.18 Приборы квантовой и оптической электроники 2.1.19 Процессы вакуумной и плазменной электроники 2.1.20 Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики 2.1.21 Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом 2.1.22 Элементы и устройства матенитоэлектроники 2.1.23 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах 2.1.24 Ионно-плазменная обработка материалов 2.1.25 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники 2.1.26 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем 2.1.27 Методы исследования материалов и структур электроники 2.1.28 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ 2.1.29 Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок 2.1.30 Полевые полупроводниковые приборы 2.1.31 Полупроводниковая наноэлектроника 2.1.32 Приемники оптические модели процессов наноэлектроники 2.1.33 Физико-математические модели процессов наноэлектроники 2.1.34 Функциональная наноэлектроника 2.1.35 Биполярные полупроводниковые приборы	2.1.15	Оборудование производства ферритовых материалов и радиокерамики					
2.1.18 Приборы квантовой и оптической электроники 2.1.19 Процессы вакуумной и плазменной электроники 2.1.20 Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики 2.1.21 Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом 2.1.22 Элементы и устройства магнитоэлектроники 2.1.23 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах 2.1.24 Ионно-плазменная обработка материалов 2.1.25 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники 2.1.26 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем 2.1.27 Методы исследования материалов и структур электроники 2.1.28 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ 2.1.29 Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок 2.1.30 Половые полупроводниковые приборы 2.1.31 Полупроводниковая наноэлектроника 2.1.32 Приемники оптического излучения 2.1.33 Физико-математические модели процессов наноэлектроники 2.1.34 Физические основы электроники 2.1.35 Физические основы электроники 2.1.36 Функциональная наноэлектроника 2.1.38	2.1.16	Основы радиационной стойкости изделий электронной техники					
2.1.19 Процессы вакуумной и плазменной электроники 2.1.20 Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики 2.1.21 Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом 2.1.22 Элементы и устройства магнитоэлектроники 2.1.23 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах 2.1.24 Ионно-плазменная обработка материалов 2.1.25 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники 2.1.26 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем 2.1.27 Методы исследования материалов и структур электроники 2.1.28 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ 2.1.29 Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок 2.1.30 Полевые полупроводниковая наноэлектроника 2.1.31 Полупроводниковая наноэлектроника 2.1.32 Физика импульсного отжига 2.1.33 Физико-математические модели процессов наноэлектроники 2.1.34 Физические основы электроники 2.1.35 Физические основы электроника 2.1.36 Функциональная наноэлектроника 2.1.38 Инженерная математика<	2.1.17	Основы технологии электронной компонентной базы					
2.1.20 Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики 2.1.21 Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом 2.1.22 Элементы и устройства магнитоэлектроники 2.1.23 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах 2.1.24 Ионно-плазменная обработка материалов 2.1.25 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники 2.1.26 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем 2.1.27 Методы исследования материалов и структур электроники 2.1.28 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ 2.1.29 Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок 2.1.30 Полевые полупроводниковые приборы 2.1.31 Полупроводниковая наноэлектроника 2.1.32 Физика импульсного отжига 2.1.33 Физико-математические модели процессов наноэлектроники 2.1.35 Физические основы электроники 2.1.36 Функциональная наноэлектроника 2.1.37 Биполярные полупроводниковые приборы 2.1.38 Инженерная математика	2.1.18	Приборы квантовой и оптической электроники					
2.1.2.1 Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом 2.1.2.2 Элементы и устройства магнитоэлектроники 2.1.2.3 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах 2.1.2.4 Ионно-плазменная обработка материалов 2.1.2.5 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники 2.1.2.6 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем 2.1.2.7 Методы исследования материалов и структур электроники 2.1.2.8 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ 2.1.2.9 Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок 2.1.3.1 Полевые полупроводниковые приборы 2.1.3.2 Приемники оптического излучения 2.1.3.3 Физика импульсного отжига 2.1.3.4 Физико-математические модели процессов наноэлектроники 2.1.3.5 Физические основы электроники 2.1.3.6 Функциональная наноэлектроника 2.1.3.7 Биполярные полупроводниковые приборы 2.1.3.8 Инженерная математика	2.1.19	Процессы вакуумной и плазменной электроники					
2.1.22 Элементы и устройства магнитоэлектроники 2.1.23 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах 2.1.24 Ионно-плазменная обработка материалов 2.1.25 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники 2.1.26 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем 2.1.27 Методы исследования материалов и структур электроники 2.1.28 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ 2.1.29 Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок 2.1.30 Полевые полупроводниковые приборы 2.1.31 Полупроводниковая наноэлектроника 2.1.32 Физика импульсного отжига 2.1.33 Физико-математические модели процессов наноэлектроники 2.1.35 Физические основы электроники 2.1.36 Функциональная наноэлектроника 2.1.37 Биполярные полупроводниковые приборы 2.1.38 Инженерная математика	2.1.20	Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики					
2.1.23 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах 2.1.24 Ионно-плазменная обработка материалов 2.1.25 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники 2.1.26 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем 2.1.27 Методы исследования материалов и структур электроники 2.1.28 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ 2.1.29 Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок 2.1.30 Полевые полупроводниковая наноэлектроника 2.1.31 Полупроводниковая наноэлектроника 2.1.32 Физика импульсного отжига 2.1.33 Физико-математические модели процессов наноэлектроники 2.1.35 Физические основы электроники 2.1.36 Функциональная наноэлектроника 2.1.37 Биполярные полупроводниковые приборы 2.1.38 Инженерная математика	2.1.21	Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом					
2.1.24 Ионно-плазменная обработка материалов 2.1.25 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники 2.1.26 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем 2.1.27 Методы исследования материалов и структур электроники 2.1.28 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ 2.1.29 Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок 2.1.30 Полевые полупроводниковые приборы 2.1.31 Полупроводниковая наноэлектроника 2.1.32 Приемники оптического излучения 2.1.33 Физика импульсного отжига 2.1.34 Физико-математические модели процессов наноэлектроники 2.1.35 Функциональная наноэлектроника 2.1.37 Биполярные полупроводниковые приборы 2.1.38 Инженерная математика	2.1.22	Элементы и устройства магнитоэлектроники					
2.1.25 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники 2.1.26 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем 2.1.27 Методы исследования материалов и структур электроники 2.1.28 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ 2.1.29 Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок 2.1.30 Полевые полупроводниковые приборы 2.1.31 Полупроводниковая наноэлектроника 2.1.32 Приемники оптического излучения 2.1.33 Физика импульсного отжига 2.1.34 Физико-математические модели процессов наноэлектроники 2.1.35 Физические основы электроники 2.1.36 Функциональная наноэлектроника 2.1.37 Биполярные полупроводниковые приборы 2.1.38 Инженерная математика	2.1.23						
2.1.26 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем 2.1.27 Методы исследования материалов и структур электроники 2.1.28 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ 2.1.29 Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок 2.1.30 Полевые полупроводниковая наноэлектроника 2.1.31 Полупроводниковая наноэлектроника 2.1.32 Приемники оптического излучения 2.1.33 Физика импульсного отжига 2.1.34 Физико-математические модели процессов наноэлектроники 2.1.35 Физические основы электроники 2.1.36 Функциональная наноэлектроника 2.1.37 Биполярные полупроводниковые приборы 2.1.38 Инженерная математика	2.1.24	Ионно-плазменная обработка материалов					
2.1.27 Методы исследования материалов и структур электроники 2.1.28 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ 2.1.29 Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок 2.1.30 Полевые полупроводниковые приборы 2.1.31 Полупроводниковая наноэлектроника 2.1.32 Приемники оптического излучения 2.1.33 Физика импульсного отжига 2.1.34 Физико-математические модели процессов наноэлектроники 2.1.35 Физические основы электроники 2.1.36 Функциональная наноэлектроника 2.1.37 Биполярные полупроводниковые приборы 2.1.38 Инженерная математика	2.1.25	Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники					
2.1.28 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ 2.1.29 Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок 2.1.30 Полевые полупроводниковая наноэлектроника 2.1.31 Полупроводниковая наноэлектроника 2.1.32 Приемники оптического излучения 2.1.33 Физика импульсного отжига 2.1.34 Физико-математические модели процессов наноэлектроники 2.1.35 Физические основы электроники 2.1.36 Функциональная наноэлектроника 2.1.37 Биполярные полупроводниковые приборы 2.1.38 Инженерная математика	2.1.26	Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем					
2.1.29 Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок 2.1.30 Полевые полупроводниковые приборы 2.1.31 Полупроводниковая наноэлектроника 2.1.32 Приемники оптического излучения 2.1.33 Физика импульсного отжига 2.1.34 Физико-математические модели процессов наноэлектроники 2.1.35 Физические основы электроники 2.1.36 Функциональная наноэлектроника 2.1.37 Биполярные полупроводниковые приборы 2.1.38 Инженерная математика	2.1.27						
2.1.30 Полевые полупроводниковые приборы 2.1.31 Полупроводниковая наноэлектроника 2.1.32 Приемники оптического излучения 2.1.33 Физика импульсного отжига 2.1.34 Физико-математические модели процессов наноэлектроники 2.1.35 Физические основы электроники 2.1.36 Функциональная наноэлектроника 2.1.37 Биполярные полупроводниковые приборы 2.1.38 Инженерная математика	2.1.28	Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ					
2.1.31 Полупроводниковая наноэлектроника 2.1.32 Приемники оптического излучения 2.1.33 Физика импульсного отжига 2.1.34 Физико-математические модели процессов наноэлектроники 2.1.35 Физические основы электроники 2.1.36 Функциональная наноэлектроника 2.1.37 Биполярные полупроводниковые приборы 2.1.38 Инженерная математика	2.1.29	Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок					
2.1.32 Приемники оптического излучения 2.1.33 Физика импульсного отжига 2.1.34 Физико-математические модели процессов наноэлектроники 2.1.35 Физические основы электроники 2.1.36 Функциональная наноэлектроника 2.1.37 Биполярные полупроводниковые приборы 2.1.38 Инженерная математика	2.1.30	Полевые полупроводниковые приборы					
2.1.33 Физика импульсного отжига 2.1.34 Физико-математические модели процессов наноэлектроники 2.1.35 Физические основы электроники 2.1.36 Функциональная наноэлектроника 2.1.37 Биполярные полупроводниковые приборы 2.1.38 Инженерная математика	2.1.31	Полупроводниковая наноэлектроника					
2.1.34 Физико-математические модели процессов наноэлектроники 2.1.35 Физические основы электроники 2.1.36 Функциональная наноэлектроника 2.1.37 Биполярные полупроводниковые приборы 2.1.38 Инженерная математика		Приемники оптического излучения					
2.1.35 Физические основы электроники 2.1.36 Функциональная наноэлектроника 2.1.37 Биполярные полупроводниковые приборы 2.1.38 Инженерная математика		Физика импульсного отжига					
2.1.36 Функциональная наноэлектроника 2.1.37 Биполярные полупроводниковые приборы 2.1.38 Инженерная математика		Физико-математические модели процессов наноэлектроники					
Биполярные полупроводниковые приборы Инженерная математика		Физические основы электроники					
2.1.38 Инженерная математика							
-		1					
2.1.39 Квантовая и оптическая электроника		-					
<u> </u>	2.1.39						
2.1.40 Материаловедение полупроводников и диэлектриков							
		Технология материалов электронной техники					
2.1.42 Физика диэлектриков		Физика диэлектриков					
2.1.43 Физика конденсированного состояния		-					
2.1.44 Физика магнитных явлений	2.1.44	Физика магнитных явлений					

2.1.45	Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники
2.1.46	Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике
2.1.47	Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике
2.1.48	Статистическая физика
2.1.49	Физические свойства кристаллов
2.1.50	Электроника
2.1.51	Математическая статистика и анализ данных
2.1.52	Методы математической физики
2.1.53	Практическая кристаллография
2.1.54	Физика
2.1.55	Физическая химия
2.1.56	Математика
2.1.57	Органическая химия
2.1.58	Химия
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	
	предшествующее: Основы надежности элементной базы электроники в условиях ионизирующего излучения космического
2.2.1	предшествующее: Основы надежности элементной базы электроники в условиях ионизирующего излучения космического пространства
2.2.1	предшествующее: Основы надежности элементной базы электроники в условиях ионизирующего излучения космического пространства Проектирование и технология электронной компонентной базы
2.2.1 2.2.2 2.2.3	предшествующее: Основы надежности элементной базы электроники в условиях ионизирующего излучения космического пространства Проектирование и технология электронной компонентной базы Радиационно-технологические процессы в электронике
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4	предшествующее: Основы надежности элементной базы электроники в условиях ионизирующего излучения космического пространства Проектирование и технология электронной компонентной базы Радиационно-технологические процессы в электронике Технологии материалов для радиопоглащения и электромагнитного экранирования Физика и техника магнитной записи Электроника органических полупроводников (материалы, технологии, приборы)
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5	предшествующее: Основы надежности элементной базы электроники в условиях ионизирующего излучения космического пространства Проектирование и технология электронной компонентной базы Радиационно-технологические процессы в электронике Технологии материалов для радиопоглащения и электромагнитного экранирования Физика и техника магнитной записи
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6	предшествующее: Основы надежности элементной базы электроники в условиях ионизирующего излучения космического пространства Проектирование и технология электронной компонентной базы Радиационно-технологические процессы в электронике Технологии материалов для радиопоглащения и электромагнитного экранирования Физика и техника магнитной записи Электроника органических полупроводников (материалы, технологии, приборы)
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7	предшествующее: Основы надежности элементной базы электроники в условиях ионизирующего излучения космического пространства Проектирование и технология электронной компонентной базы Радиационно-технологические процессы в электронике Технологии материалов для радиопоглащения и электромагнитного экранирования Физика и техника магнитной записи Электроника органических полупроводников (материалы, технологии, приборы) Электронные и оптические свойства широкозонных соединений А2В6
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8	предшествующее: Основы надежности элементной базы электроники в условиях ионизирующего излучения космического пространства Проектирование и технология электронной компонентной базы Радиационно-технологические процессы в электронике Технологии материалов для радиопоглащения и электромагнитного экранирования Физика и техника магнитной записи Электроника органических полупроводников (материалы, технологии, приборы) Электронные и оптические свойства широкозонных соединений А2В6 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9	предшествующее: Основы надежности элементной базы электроники в условиях ионизирующего излучения космического пространства Проектирование и технология электронной компонентной базы Радиационно-технологические процессы в электронике Технологии материалов для радиопоглащения и электромагнитного экранирования Физика и техника магнитной записи Электроника органических полупроводников (материалы, технологии, приборы) Электронные и оптические свойства широкозонных соединений А2В6 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, COOTHECEHHЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ОПК-2: Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения задач в профессиональной области

Знать:

ОПК-2-31 Предназначение современных видов оборудования для проведения анализа и измерений параметров наноразмерных объектов

ПК-5: Способность проводить анализ и выбор перспективных технологических процессов при производстве изделий микроэлектроники

Знать:

ПК-5-31 Основные задачи, направления, тенденции и перспективы развития нанотехнологии, а также смежных областей науки и техники

ОПК-1: Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности

Знать:

ОПК-1-31 Теоретические основы мессбауэровской спектроскопии

ПК-5: Способность проводить анализ и выбор перспективных технологических процессов при производстве изделий микроэлектроники

Уметь:

ПК-5-У1 Делать выводы по улучшению потребительских свойств нано- и магнитных материалов на основе результатов проведенных экспериментов.

ОПК-1: Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности

Уметь:

ОПК-1-У1 Применять методы и компьютерные системы моделирования и анализа материалов и компонентов нано- и

микросистемной техники

ОПК-2: Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения задач в профессиональной области

VMeth

ОПК-2-У1 Проводить интерпретацию мессбауэровских спектров

ПК-5: Способность проводить анализ и выбор перспективных технологических процессов при производстве изделий микроэлектроники

Владеть:

ПК-5-В1 Навыками работы в области применения мессбауэровской спектроскопии для исследования свойств наноматериалов

ОПК-2: Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения задач в профессиональной области

Владеть:

ОПК-2-В1 Методами измерения мёссбауэровских спектров при температурах от жидкого азота до комнатной

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ								
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Формируемые индикаторы компетенций	Литература и эл. ресурсы	Примечание	КМ	Выполн яемые работы
	Раздел 1. Теоретические основы мессбауэровской спектроскопии. Параметры мессбауэровских спектров.							
1.1	Вводное занятие. Научные исследования материалов нано- и микросистемной техники и методы, используемые для их проведения. /Лек/	10	1	ПК-5-31 ОПК- 2-31	Л1.1Л2.1			
1.2	Физическая сущность эффекта Мёссбауэра. Изотопы, на которых наблюдается эффект Мёссбауэра и схемы их ядерных переходов. Блок схема мёссбауэровского спектрометра и принципего работы. /Лек/	10	2	ОПК-1-31	Л1.1Л2.1			
1.3	Параметры мессбауэровских спектров: изомерный сдвиг, температурный сдвиг, ширина резонансных линий. /Лек/	10	2	ОПК-1-31	Л1.1Л2.1			
1.4	Параметры мессбауэровских спектров: квадрупольное расщепление, магнитные поля на ядах Fe57. /Лек/	10	2	ОПК-1-31	Л1.1Л2.1			
1.5	Расчет химической формулы кальциевого феррита по данным рентгеноспектрального микроанализа /Пр/	10	2	ОПК-2-31 ПК- 5-31 ОПК-1- У1	Л1.1Л2.1			P1
1.6	Выполнение домашнего задания и подготовка к его защите /Ср/	10	6	ОПК-2-31 ОПК-1-У1	Л1.1Л2.1			P1

	Раздел 2. Программа обработки мессбауэровских спектров и получаемая из них информация.						
2.1	Программа обработки мессбауэровских спектров. /Лек/	10	1	ОПК-2-31 ОПК-1-31	Л1.1Л2.1		
2.2	Физическая и практическая информация, извлекаемая из мессбауэровских параметров. /Лек/	10	1	ОПК-2-31	Л1.1Л2.1		
2.3	Лабораторная работа № 1. Освоение программы обработки мессбауэровских спектров «Univem MS» /Лаб/	10	2	ОПК-2-У1 ОПК-2-В1	Л1.1Л2.1		P2
2.4	Лабораторная работа №2. Расчет параметров мессбауэровских спектров и диагностика компонентов спектра /Лаб/	10	3	ОПК-2-У1	Л1.1Л2.1		Р3
2.5	Обработка и интерпретация мессбауэровских спектров с помощью программы Univem MS /Пр/	10	15	ОПК-2-У1	Л1.1Л2.1		
2.6	Подготовка к практическим занятиям /Ср/	10	15	ОПК-2-У1 ОПК-1-У1 ПК -5-У1 ПК-5-В1	Л1.1Л2.1		
	Раздел 3. Применение мессбауэровской спектроскопии для изучения металлов, сплавов и оксидов железа и наноматериалов на их основе.						
3.1	Применение мессбауэровской спектроскопии для изучения металлов, сплавов. Принцип расчета кристаллохимических формул по мёссбауэровским спектрам. /Лек/	10	2	ОПК-1-31	Л1.1Л2.1		
3.2	Эффект Мёссбауэра на ядах Fe57 металлического железа и интерметаллических соединений. /Лек/	10	2	ОПК-1-31	Л1.1Л2.1		
3.3	Применение мессбауэровской спектроскопии для изучения оксидов железа, используемых в наноматериалах. Их структура и свойства. /Лек/	10	4	ОПК-2-31 ПК- 5-31	Л1.1Л2.1		
3.4	Мессбауэровская спектроскопия суперпарамагнитных материалов. /Лек/	10	1	ОПК-1-31	Л1.1Л2.1		

2.5	In T	10		OFFICA 21	тт 1 1	1	1 1	
3.5	Применение мессбауэровской спектроскопии для изучения ферритов: ферритов-шпинелей, ферритов-гранатов, ортоферритов и гексагональных ферритов. Их структура и свойства. /Лек/	10	6	ОПК-1-31	Л1.1 Л1.2Л2.1			
3.6	Лабораторная работа № 3. Определение кристаллохимических формул магнитных материалов по данным мессбауэровской спектроскопии /Лаб/	10	3	ОПК-2-У1 ОПК-1-У1 ПК -5-У1	Л1.1Л2.1			P4
3.7	Лабораторная работа № 4. Определение степени восстановления железа в материалах по данным мессбауэровской спектроскопии /Лаб/	10	3	ПК-5-У1 ОПК -2-У1 ОПК-1- У1	Л1.1Л2.1			P5
3.8	Лабораторная работа № 5. Определение степени нестехиометрии магнетита с помощью мессбауэровской спектроскопии /Лаб/	10	3	ПК-5-У1 ОПК -1-У1 ОПК-2- У1 ПК-5-В1	Л1.1Л2.1			P6
3.9	Лабораторная работа № 6. Определение степени текстурирования магнитных материалов с помощью мессбауэровской спектроскопии /Лаб/	10	3	ПК-5-У1 ОПК -2-У1 ПК-5-В1	Л1.1Л2.1			P7
3.10	Подготовка к защите лабораторных работ /Ср/	10	30	ОПК-2-У1 ОПК-1-У1 ПК -5-У1	Л1.1Л2.1 Э1			
3.11	Написание реферата и подготовка к его защите /Ср/	10	25	ОПК-1-31 ОПК-2-31 ПК- 5-У1 ПК-5-31	Л1.1Л2.1			P8
	Раздел 4. Мессбауэровская спектроскопия на конверсионных электронах и ее применение для изучения наноматериалов и их поверхности.							
4.1	Мессбауэровская спектроскопия на конверсионных электронах, ее физические основы, достоинства и недостатки. /Лек/	10	2	ОПК-1-31	Л1.1Л2.1			
4.2	Применение мессбауэровской спектроскопии на конверсионных электронах для изучения наноматериалов. /Лек/	10	1	ОПК-1-31 ПК- 5-31	Л1.1Л2.1			

4.3	Применение мёссбауэровской спектроскопии на отражение для изучения поверхности наноматериалов. /Лек/	10	1	ОПК-1-31 ПК- 5-31	Л1.1Л2.1		
	Раздел 5. Мессбауэровская спекроскопия в исследованиях полупроводников, легированных оловом.						
5.1	Мессбауэровская спектроскопия Sn-119, особенности спектров олова и их характерные параметры. /Лек/	10	2	ОПК-1-31	Л1.1Л2.1		
5.2	Мессбауэровская спектроскопия оксидных проводников, легированных оловом. /Лек/	10	2	ОПК-1-31	Л1.1Л2.1		
5.3	Мессбауэровская спектроскопия Sn-119 в халькогенидных сплавах сложного состава. /Лек/	10	2	ОПК-1-31	Л1.1Л2.1		

	5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ						
5.1. Контрольные мероприятия (контрольная работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для самостоятельной подготовки							
Код КМ	Контрольное мероприятие	Проверяемые индикаторы компетенций	Вопросы для подготовки				
KM1	Экзамен	ОПК-2-31;ОПК-1-31;ПК-5-31	Вопросы к экзаменационным билетам курса ПК-5-31 Основные задачи, направления, тенденции и перспективы развития нанотехнологии, а также смежных областей науки и техники 1. Применение мессбауэровской спектроскопии для изучения поверхности наноматериалов. 2. Применение мессбауэровской спектроскопии для изучения однои двухслойных пленок. 5. Наноматериалы и роль мессбауэровской спектроскопии в их изучении. ОПК-2-31 Предназначение современных видов оборудования для проведения анализа и измерений параметров наноразмерных объектов: 1. Методы фазового анализа материалов и место в них мессбауэровской спектроскопии. 2. Информация, получаемая из мессбауэровских спектров и области использования мессбауэровской спектроскопии. 3. Примеры применения мессбауэроской спектроскопии для изучения дисперсности ферритов. 4. Суперпарамагнетизм, причины его появления и диагностика. 6. Магнитные свойства наноматериалов и методы их определения. 7. Виды магнитного упорядочения и их диагностика по мессбауэровским спектрам 8. Порядок расчета кристаллохимических формул оксидов железа по данным химического или спектрального анализа. 9. Порядок расчета кристаллохимических формул интерметаллических соединений по данным мессбауэровской спектроскопии. 10. Использование мессбауэровской спектроскопии для определения степени восстановления и окисления железа. 11. Программа обработки мессбауэровских спектров и ее возможности				

УП: 11.03.04-БЭН-23 6-ПП.plx

стр. 9

- ОПК-1-31 Теоретические основы мессбауэровской спектроскопии:
- 1. Сущность эффекта Мёссбауэра. Изотопы, на которых наблюдался эффект и наиболее используемые.
- 2. Аппаратура для наблюдения эффекта Мёссбауэра и блок схема мессбауэровского спектрометра. Возможности измерения спектров при низких температурах и в магнитном поле.
- 3. Мессбауэровская спектроскопия на конверсионных электронах и ее реализация
- 4. Параметры мессбауэровских спектров: величина резонансного эффекта и вероятность резонансного эффекта. Их связь с составом и структурой материалов.
- 5. Ширина резонансной линии, ее определение и влияние на характеристики мессбауэровского спектра.
- 6. Изомерный химический сдвиг и его физическая сущность, способы определения и причины различия у ионов железа. Зависимость изомерного сдвига от координации ионов железа.
- 7. Квадрупольное расщепление. Причины его возникновения и способы определения. Различия квадрупольного расщепления для двух и трехвалентного железа и связь со степенью искажения координационных полиэдров.
- 8. Асимметрия квадрупольного дублета и причины ее появления.
- 9. Магнитная структура вещества и ее отражение в мессбауэровских спектрах. Причины возникновения и определяемый магнитный параметр по мессбауэровским спектрам.
- 10. Металлическое железо, мессбауэровская спектроскопия α-Fe. Различия между α-Fe и γ-Fe. Температура Кюри.
- 1 Гематит. Мессбауэровская спектроскопия гематита, магнитная и кристаллическая структура, фазовые переходы в гематите и их последствия. Температура Нееля.
- 12. Магнетит. Мессбауэровская спектроскопия магнетита. Распределение ионов железа в магнетите, характер магнитного упорядочения, фазовые переходы в магнетите.
- 13. Вюстит. Мессбауэровсий спектр вюстита и его параметры.
- 14. Возможность определения степени нестехиометрии магнетита по его мессбауэровским спектрам и наличия изоморфных замешений.
- 15. Мессбауэровская спектроскопия интерметаллических соединений. Возможности мессбауэровской спектроскопии при их исследовании.
- 16. Мессбауэровская спектроскопия ферритов шпинелей. Хромшпинелид, особенности его мессбауэровского спектра и параметры. Способ определения в нем содержания алюминия.
- 17. Никелевый феррит. Мессбауэровский спектр никелевого феррита, его расшифровка и особенности при измерениях в магнитном поле.
- 18. Феррит кобальта. Мессбауэровский спектр и его особенности.
- 19. Феррит марганца. Мессбауэровский спектр и его особенности.
- 20. Ферриты-гранаты. Мессбауэровский спектр иттриевого феррита граната, его расшифровка и параметры.
- 21. Мессбауэровские спектры парамагнитных ферритов-гранатов и их характеристика. Отличие от магнитоупорядоченных ферритов.
- 22. Редкоземельные орто-ферриты, их структура, мессбауэровские спектры и их параметры.
- 23. Гексагональные ферриты. Типы структур гексагональных ферритов. Мессбауэровские спектры ферритов со структурой М и их расшифровка.
- 24. Мессбауэровская спектроскопия Sn119. Источники, калибровка спектров, Соединения, относительно которых рассчитывается химический сдвиг.
- 25. Электронная и дырочная проводимость в полупроводниках кремния.
- 26. Мессбауэровская спектроскопия оксидных полупроводников Sn119 MnO и Fe0,85O.
- 27. Мессбауэровская спектроскопия оксидных полупроводников Sn119 CoO и NiO.
- 28. Понятие об одно- и двухэлектронных центрах в керамических полупроводниках.
- 29. Зонная модель двухэлектронных центров олова в халькогенидах

5.2. Пере	чень работ, выполня		свинца для U<0. 30. Исследование состояние примесных атомов олова в стеклообразных полупроводниковых сплавах Ge-Pb-Se-Sn. 31. Исследование состояние примесных атомов железа в стеклообразных полупроводниковых сплавах Ge-Pb-S-Fe. (Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР и т.п.)
Код работы	Название работы	Проверяемые индикаторы компетенций	Содержание работы
P1	Домашнее задание	ОПК-1-У1	"Расчет химической формулы кальциевого феррита по данным рентгеноспектрального микроанализа" Вопросы к домашнему заданию 1. Какова физическая основа рентгеноспектрального микрозондирования? 2. Приведите уравнение Вульфа-Брегга и укажите, какой параметр в нем определяют при диагностике состава? 3. Какие возможности имеет рентгеноспектральный анализ при изучении вещества? 4. В каких режимах может работать рентгеноспектральный микроанализ? 5. Как осуществляется идентификация элемента в режиме анализа? 6. Какие принципы заложены для количественного определения содержания элемента? 7. Какие существуют виды химического анализа?
P2	Лабораторная работа № 1	ОПК-2-В1;ОПК-1- У1	Освоение программы обработки мессбауэровских спектров «Univem Ms» Контрольные вопросы к лабораторной работе 1 1. Какова физическая сущность эффекта Мёссбауэра? 2. Какие основные параметры мессбауэровских спектров? 3. Как калибруется мессбауэровский спектр? 4. Какие существуют способы обработки мессбауэровских спектров? 5. Какова последовательность операций при обработке спектра на компьютере? 6. Какую информацию можно получить из мессбауэровских спектров?
P3	Лабораторная работа № 2	ОПК-2-У1	Расчет параметров мессбауэровских спектров и диагностика компонентов спектра Контрольные вопросы к лабораторной работе 2 1. Какие основные параметры мессбауэровских спектров? 2. Как калибруется мессбауэровский спектр? 3. Какова последовательность операций при обработке спектра на компьютере? 4. Какую информацию можно получить из мессбауэровских спектров? 5. Как определяется изомерный сдвиг для дублетов и секстетов? 6. Как определяется квадрупольное расщепление для дублетов и секстетов?

P4	Лабораторная работа № 3	ОПК-2-У1;ОПК-1- У1;ПК-5-У1	Определение кристаллохимических формул магнитных материалов по данным мессбауэровской спектроскопии
			Контрольные вопросы к лабораторной работе 3 1. В каких случаях применима методика определения кристаллохимических формул материалов? 2. Чем отличается кристаллохимическая формула вещества от химической? 3. Какие мессбауэровские параметры используются при расчете кристаллохимических формул? 4. Что такое координационное число катионов? 5. Какова последовательность операций при определении кристаллохимических формул? 6. Какую информацию можно получить из мессбауэровских спектров?
P5	Лабораторная работа № 4	ОПК-2-У1;ОПК-1- У1;ПК-5-У1	Определение степени восстановления железа в материалах по данным мессбауэровской спектроскопии Контрольные вопросы к лабораторной работе 4 1. Почему мессбауэровскую спектроскопию целесообразно использовать при определении степени восстановления железа?
			 Что происходит с железом при восстановлении его из оксидов? Чем характеризуется восстановимость железа? Как определяется степень восстановления железа по мессбауэровским спектрам? Почему степень восстановления железа нужно определять не по валентности железа, а по потере кислорода? Когда непосредственно только по мессбауэровским спектрам можно судить о степени восстановления железа?
P6	Лабораторная работа № 5	ОПК-2-У1;ОПК-1- У1;ПК-5-У1;ПК-5- В1	Определение степени нестехиометрии магнетита с помощью мессбауэровской спектроскопии Контрольные вопросы к лабораторной работе 5 1. В чем заключается нестехиометрия магнетита? 2. Почему экспериментальное отношение S A /S B в незамещенном магнетите не соответствует 0,5, а имеет небольшое отклонение? 3. Какой механизм образования нестехиометрического магнетита? 4. Что представляет собой конечный член ряда магнетит-маггемит? 5. Как выводится формула определения отношения S A /S B из экспериментальных мессбауэровских спектров? 6. Какова кристаллохимическая формула общего вида нестехиометрического магнетита?
			7. В каких пределах изменяется коэффициент х в формуле общего вида членов магнетит-маггемитового ряда?
P7	Лабораторная работа № 6	ПК-5-В1;ПК-5- У1;ОПК-2-У1	Определение степени текстурирования магнитных материалов с помощью мессбауэровской спектроскопии Контрольные вопросы к лабораторной работе 6 1. Какое соотношение интенсивностей пиков в секстете, если угол 0 = 55°? 2. Какое соотношение интенсивностей пиков в секстете, если угол 0 = 90°? 3. Какое соотношение интенсивностей пиков в секстете, если угол 0 = 0°? 4. Что показывает угол 0? 5. Как определяется степень текстурирования?

P8	Реферат	ОПК-2-31;ОПК-1-	Реферат на тему "Возможности применения мессбауэровской
		31;ПК-5-31;ПК-5-	спектроскопии при подготовке ВКР на тему "ТЕМА ВКР
		У1	СТУДЕНТА"
			или "Мессбауэровская спектроскопия в изучении "НАЗВАНИЕ
			МАТЕРИАЛА ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА (например, ферритов-
			гранатов)"
			при отсутствии приложения мессбауэровской спектроскопии к теме ВКР

5.3. Оценочные материалы, используемые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)

Экзаменационный билет состоит из 3-х теоретических вопросов. Билеты хранятся на кафедре.

5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)

К экзамену допускается студент, выполнивший и защитивший домашнее задание, все лабораторные работы и реферат.

Оценка "отлично" выставляется за 3 правильных ответа на экзаменационные вопросы.

Оценка "хорошо" выставляется за 2 правильных ответа на экзаменационные вопросы.

Оценка "удовлетворительно" выставляется за 1 правильный ответ на экзаменационные вопросы.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 6.1. Рекомендуемая литература 6.1.1. Основная литература Авторы, составители Заглавие Библиотека Издательство, год Библиотека МИСиС М.: Наука, 1980 Л1.1 Жданов Г. С., Дифракционный и Илюшин А. С., резонансный структурный Никитина С. В., анализ: Рентгено-, электроно Жданов Г. С. -, нейтрономессбауэрография и мессбауэровская спектроскопия: Учеб. пособие для вузов Л1.2 Летюк Л. М., Технология ферритовых М.: Изд-во МИСиС, 2005 Электронная библиотека Костишин В. Г., материалов Гончар А. В. магнитоэлектроники 6.1.2. Дополнительная литература Библиотека Авторы, составители Заглавие Издательство, год Л2.1 Карпов Ю. А., Аналитический контроль в Библиотека МИСиС М.: Академкнига, 2006 Савостин А. П., металлургическом Сальников В. Д. производстве: учеб. пособие для студ. вузов напр. 'Металлургия' 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» LMS Canvas https://lms.misis.ru/ Э1 6.3 Перечень программного обеспечения Microsoft Office Π.1 Π.2 Win Pro 10 32-bit/64-bit 6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных

	7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ						
Ауд.	Назначение	Оснащение					
K-427	Учебная аудитория	стационарные компьютеры 6 шт., 4 ноутбука, пакет лицензионных программ MS Office, набор демонстрационного оборудования в том числе: доска учебная, мультимедийный проектор, экран проекционный, комплект учебной мебели 25 посадочных мест					
Читальный зал №3 (Б)		комплект учебной мебели на 44 места для обучающихся, МФУ Хегох VersaLink B7025 с функцией масштабирования текстов и изображений, 8 ПК с доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus.					

Любой	корпус	Учебная аудитория для проведения комплект учебной мебели до 36 мест для обучающихся,
Мультимедийная		занятий лекционного типа и/или для мультимедийное оборудование, магнитно-маркерная
		проведения практических занятий: доска, рабочее место преподавателя, ПКс доступом к
		ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный
		кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные
		программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus
K-427		Учебная аудитория стационарные компьютеры 6 шт., 4 ноутбука, пакет
		лицензионных программ MS Office, набор
		демонстрационного оборудования в том числе: доска
		учебная, мультимедийный проектор, экран
		проекционный, комплект учебной мебели 25
		посадочных мест

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Рекомендуется ознакомиться с литературой, находящейся в Российской государственной библиотеке:

- 1. Мессбауэровская спектроскопия и ее применение для химической диагностики неорганических материалов: конспект лекций для студентов старших курсов и аспирантов Химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова / П. Б. Фабричный, К. В. Похолок. Москва: Принт-Ателье, 2009 (М.: ЗАО "Принт-Ателье"). 142 с.: ил., табл.; 22 см.; ISBN 978 -5-88762-003-9
- 2. Основы мессбауэровской спектроскопии [Текст] : учебное пособие / В. С. Русаков. Москва : Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 2011. 290 с. : ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-5-8279-0097-9

На кафедре в электронном виде имеется Учебное пособие «Мессбауэровская спектроскопия материалов электроники» и Лабораторный практикум.

«Мессбауэровская спектроскопия материалов электроники»